К 90-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА ГРИГОРЬЕВИЧА ШАВРОВА

УДК 537.638.5,537.622.5

ОБРАТНЫЙ МАГНИТОКАЛОРИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ В СОЕДИНЕНИИ Мп₅Si₃

© 2023 г. А. С. Кузнецов^{*a*, *}, А. В. Маширов^{*a*}, И. И. Мусабиров^{*b*}, В. И. Митюк^{*c*}, М. С. Аникин^{*d*}, А. П. Каманцев^{*a*}, В. В. Коледов^{*a*}, В. Г. Шавров^{*a*}

^а Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, ул. Моховая, 11, корп. 7, Москва, 125009 Российская Федерация ^b Институт проблем сверхпластичности металлов РАН, ул. Степана Халтурина, 39, Уфа, 450001 Российская Федерация ^c Научно-практический центр НАН Беларуси по материаловедению, Минск, Республика Беларусь ^d Уральский федеральный университет, просп. Ленина, 51, Екатеринбург, 620075 Российская Федерация *E-mail: kuznetsovalserg@gmail.com Поступила в редакцию 22.09.2022 г.

После доработки 12.10.2022 г. Принята к публикации 18.10.2022 г.

Прямым методом проведены исследования магнитокалорического эффекта (МКЭ) для образцов соединения Mn_5Si_3 в адиабатических условиях в магнитных полях до 2 Тл при криогенных температурах в диапазоне от 25 до 125 К. По результатам измерений показано, что при температурах вблизи метамагнитоструктурного фазового перехода 1-го рода из неколлинеарного антиферромагнитного в коллинеарное антиферромагнитное состояние наблюдаются как обратный, так и прямой МКЭ. Максимальное значение обратного МКЭ составило $\Delta T_{ad} = -0.27$ К при начальной температуре $T_0 = 55$ К в магнитном поле 2 Тл. Прямой МКЭ с максимальным значением $\Delta T_{ad} = +0.23$ К наблюдается при $T_0 = 70$ К в поле 2 Тл.

DOI: 10.31857/S0033849423040083, EDN: PFSUEW

введение

Поиск перспективных материалов, претерпевающих магнитные и магнитоструктурные фазовые переходы (ФП), является актуальным направлением в области твердотельного магнитного охлаждения [1, 2]. Воздействие внешнего магнитного поля на такие материалы вызывает в них магнитокалорический эффект (МКЭ), который представляет собой изменение температуры $\Delta T_{\rm ad}$ при нахождении материала в адиабатических условиях или изменение магнитной энтропии $\Delta S_{\rm mag}$ – в изотермических. Известно, что МКЭ принимает максимальные значения в области температур ФП и может быть как прямым, так и обратным [1]. Под прямым МКЭ понимают обратимое (в общем случае) увеличение температуры образца и, соответственно, уменьшение энтропии магнитной подсистемы при росте внешнего магнитного поля. Под обратным МКЭ, напротив, уменьшение температуры образца и увеличение энтропии магнитной подсистемы при росте внешнего магнитного поля.

Обратный МКЭ наблюдается в разных семействах материалов и сплавов вблизи температур метамагнитных ФП 1-го рода, таких как ФП, из антиферромагнитного в ферромагнитное упорядочение (A Φ M $\rightarrow \Phi$ M) [3, 4], из антиферромагнитного в *ферримагнитное* (А Φ М \rightarrow Φ ИМ) [5] и из неколлинеарного АФМ в коллинеарное АФМ упорядочение. Чаще всего одновременно с метамагнитным ФП в таких материалах происходит и структурное превращение. Некоторыми примерами систем таких материалов являются сплавы Гейслера из семейств Ni-Mn-(Sn, In) [6-11] и Ni-Mn-Co-(Ga, In) [11-15], а также семейства сплавов на основе марганца: $Mn_{2-x}Cr_xSb$ [16, 17], Mn_3MC (M = = Ga, Sn) [18–20]. Однако все перечисленные системы сплавов демонстрируют ФП 1-го рода преимушественно в области умеренно низких и комнатных температур. Особый интерес представляют материалы, в которых магнитные и магнитоструктурные ФП проявляются при криогенных температурах (ниже 120 К). Прежде всего это связано с их потенциально возможным применением в качестве хладагентов для сжижения газов, таких как гелий, водород, кислород [21, 22]. Кроме того, ранее было показано [23-26], что в тех случаях, когда магнитный ФП сопровождается структурным пре-



Рис. 1. Экспериментальные (точки) и расчетные (кривая *I*) рентгенограммы образца Mn₅Si₃; кривая 2 – разность между рентгенограммами; ряд штрихов – угловые положения брэгговских рефлексов основной фазы, в круглых скобках приведены индексы Миллера.

вращением, приложение магнитного поля может совместно с магнитным вкладом вносить сильный решеточный вклад в конечное изменение энтропии материала и тем самым вызывать высокие значения МКЭ.

Одним из таких материалов является соединение Mn₅Si₃. Согласно литературным сведениям [27-35] при комнатной температуре данное соединение имеет гексагональную структуру типа *D*8₈ с пространственной группой *P*6₃/*mcm* и двумя локализованными кристаллографическими позициями атомов Mn: 4 (*d*) и 6 (*f*) (обозначается как Mn1 и Mn2 соответственно) с парамагнитным (ПМ) фазовым состоянием [27, 28]. Установлено, что соединение Mn₅Si₃ претерпевает два последовательных ФП при понижении температуры: магнитоструктурный ФП из ПМ-фазы в коллинеарную АФМ-фазу (АФ2) вблизи $T_{N2} \approx 99$ К, и метамагнитоструктурный ФП из коллинеарной АФМфазы (АФ2) в неколлинеарную АФМ-фазу (АФ1) вблизи $T_{N1} \approx 66$ К (рис. 1). Ниже температуры T_{N2} , соединение Mn₅Si₃ претерпевает перестройку в орторомбическую структуру с центросимметричной пространственной группой Сстт, которая обусловлена коллинеарным расположением магнитных моментов атомов Mn2 с параллельной и антипараллельной ориентацией спинов, а также отсутствием упорядоченного магнитного момента атомов Mn1 [32, 34]. Неколлинеарное поведение магнитной структуры при температуре ниже T_{N1} объясняется перестроением магнитных моментов Mn2 и их расщеплением на моменты Mn21 и Mn22, а также дополнительным упорядочением магнитных моментов Mn1, которое связывают с

магнитоструктурным искажением и топологической фрустрацией [32–35]. Вместе с тем неколлинеарное $A\Phi1$ -упорядочение приводит к дополнительному структурному искажению, и симметрия магнитной структуры становится моноклинной с нецентросимметричной пространственной группой *Cc2m* [35]. В некоторых работах [27, 28], высказывалось предположение о проявлении слабого ферромагнетизма в высокотемпературной фазе $A\Phi2$.

До настоящего времени исследования, посвященные изучению магнитокалорических свойств данного материала, осуществлялись исключительно косвенными методами — путем определения изотермического изменения магнитной энтропии ΔS_{mag} . В представленной работе путем реализации прямого метода измерений, позволяющего непосредственно определить величину адиабатического изменения температуры ΔT_{ad} , проведено исследование образцов соединения Mn_5Si_3 в магнитных полях до 2 Тл при криогенных температурах в диапазоне от 25 до 125 К.

1. ОБРАЗЦЫ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ

Поликристаллические образцы соединения Mn_5Si_3 были синтезированы методом дуговой плавки в атмосфере аргона на медном водоохлаждаемом кристаллизаторе вакуумной печи из высокочистых (99.99 ат. %) навесок Mn и Si. Заготовку помещали в рабочую камеру, где выполнялась процедура плавления в атмосфере аргона с пятью переплавами — для достижения лучшей однород-



Рис. 2. SEM-изображение микроструктуры образца Mn₅Si₃ в состоянии после гомогенизационного отжига в течение 50 ч при температуре 1273 К и разном приближении: 100 (а), 50 (б) и 20 мкм (в).

ности слитка. С целью гомогенизации слиток отжигали в вакууме в течении 50 ч при температуре 1273 К с последующим естественным охлаждением в печи. Фазовый анализ и определение параметров кристаллической решетки выполнены с помощью рентгеноструктурного анализа методом рентгеновской дифракции с применением порошкового дифрактометра D8 Advance (Bruker) с источником излучения CuK α λ = 1.5406 Å. Определение элементного состава сплава выполнено на растровом электронном микроскопе Vega 3 SBH (Tescan) посредством энергодисперсионного анализа X-Act (Oxford Instruments). Для исследования микроструктуры металлографического шлифа был использован детектор обратно-рассеянных электронов (ДОРЭ), также установленный на растровом электронном микроскопе.

Магнитные свойства поликристаллических образцов Mn₅Si₃ исследовали с помощью системы Cryogenic по индукционной методике. Измерения температурных зависимостей намагниченности M(T) осуществляли в диапазоне температур 4...200 К в постоянных магнитных полях 10 мТл и 1 Тл. Измерения в поле 10 мТл проводили в процессе нагревания образцов, охлажденных до 4 К в трех режимах: охлаждение в отсутствие магнитного поля с последующим нагревом в поле (ZFC), охлажление в магнитном поле (FC) и нагрев после охлаждения в магнитном поле (FH). Измерения полевых зависимостей намагниченности М(Н) были выполнены в магнитных полях до 13.5 Тл в диапазоне температур 10...110 К. Скорость нагрева и охлаждения при измерениях намагниченности составляла 2 К/мин.

Исследование магнитокалорических свойств в образце соединения Mn_5Si_3 осуществляли с помощью сверхпроводящей криомагнитной системы методом прямого измерения адиабатического изменения температуры ΔT_{ad} дифференциальной

микротермопарой при изменении внешнего магнитного поля. Прямой экстракционный метод измерений ΔT_{ad} , реализованный в данной работе, аналогичен методу, о котором сообщалось ранее [36]. Подробное описание данного метода измерений представлено в работе [37]. Кроме того, основываясь на полученных данных для полевых зависимостей намагниченности M(H), проведен косвенный расчет изотермического изменения магнитной энтропии ΔS_{mag} образца соединения Mn_5Si_3 .

2. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

По результатам фазового анализа экспериментальной рентгенограммы синтезированного сплава (см. рис. 1), полученной при комнатной температуре, установлено, что кристаллическая структура Mn₅Si₃ с высокой степенью сходимости описывается гексагональной Р6₃/тст пространственной группой с параметрами решетки a = b = 6.91441 Å, c = 4.81609 Å. Рентгенофазовый анализ образца Mn₅Si₃ показал, что помимо основной фазы состава Mn₅Si₃ обнаружена примесная фаза состава, близкого к Mn₃Si, содержание которой составило около 2%, что хорошо согласуется с более ранними исследованиями [32, 38]. Анализ элементного состава исследуемого сплава показал, что образец имеет следующее содержание компонентов: Mn₆₃₄Si₃₆₆ (ат. %) (Mn_{5.07}Si_{2.93}). Согласно полученным данным соотношение содержания компонентов сплава соответствует ожидаемому стехиометрическому составу Mn₅Si₃. При проведении локализованного анализа поверхности металлографического шлифа показано (рис. 2), что основная матрица соответствует фазе Mn₅Si₃, которая представлена вытянутыми кристаллами длиной не более 1 мм. В основной матрице через ДОРЭ наблюдаются



Рис. 3. Зависимости намагниченности образца M соединения Mn_5Si_3 от температуры в постоянном магнитном поле 1 Тл (а) и в низком магнитном поле 10 мТл (вставка на рис. 3(а)), полученные по протоколам FC (кривая I) и FH (кривая 2); (б) – полевые зависимости намагниченности при постоянных температурах от 10 до 110 К.

светлые выделения овальной формы длиной менее 10 мкм, которые соответствуют фазе Mn₃Si.

Результаты измерений температурной зависимости намагниченности M(T) для образца Mn_5Si_3 в постоянном магнитном поле 1 Тл и полевой зависимости M(H) в диапазоне температур 10...110 К представлены на рис. За, 36. Результаты измерения температурных зависимостей намагниченности M(T) в слабом магнитном поле 10 мТл представлены на вставке рис. За. В режиме нагрева (FH), кривая намагниченности достигает максимального значения при температуре $T_{N1} = 66.9$ К, что соответствует разрушению неколлинеарного антиферромагнетизма и переходу $A\Phi 1 \rightarrow A\Phi 2$



Рис. 4. Температурная зависимость адиабатического изменения температуры ΔT_{ad} образца соединения Mn_5Si_3 в магнитных полях до 2 Тл в режиме нагрева (кривые *1* и *2*) и термоциклирования (кривые *3* и *4*): $\mu_0 H = 1$ Тл (*1* и *3*), $\mu_0 H = 2$ Тл (*2* и *4*).

[27—33]. При температуре $T_{N2} = 101.4$ К наблюдается изменение наклона кривой намагниченности, что обусловлено наличием магнитоструктурного ФП $A\Phi 2 \rightarrow \Pi M$ [33, 38–41]. Следует отметить, что в режиме охлаждения (FC), наблюдается смещение температурного хода кривой намагниченности с температурным гистерезисом шириной до 9.4 К. Поведение кривых намагничивания (см. рис. 3б) в широком диапазоне полей при температуре ниже 60 К свидетельствует о наличии индуцированного магнитным полем ФП 1-го рода, сопровождающегося температурным гистерезисом магнитных свойств, который, в свою очередь, связывают с магнитострикцией соединения [40, 41]. Обнаружено, что величина критического поля, при котором полностью завершается ФП 1-го рода, уменьшается по мере роста температуры. что хорошо согласуется с более ранними исследованиями [39-42]. Используя низкополевую зависимость M(T), полученную согласно протоколу FH, была определена температура метамагнитоструктурного $\Phi\Pi A\Phi 1 \rightarrow A\Phi 2$: $T_{\rm N1} = 66.9$ К. Температура Нееля $A\Phi 2 \rightarrow \Pi M$ была определена как $T_{N2} = 101.4$ K. Эти значения находятся в достаточно хорошем согласии с опубликованными данными [27-33, 41].

На рис. 4 представлены результаты измерения МКЭ для образца Mn_5Si_3 при адиабатическом намагничивании в широком диапазоне температур, от 25 до 125 К. Измерения проводили в режиме нагрева и термоциклирования. Диапазон термоциклирования был определен с учетом особенностей метамагнитоструктурного ФП 1-го рода $A\Phi 1 \rightarrow A\Phi 2$, чтобы исключить влияние остаточной высокотемпературной фазы $A\Phi 2$, возникающей в результате первого внесения образца в область магнитного поля. Для этого перед внесением образца в область магнитного поля осуществлялось его охлаждение до температуры ниже $\Phi\Pi$ из моноклинной в орторомбическую фазу, а затем нагрев до начальной температуры измерений T_0 .

Согласно полученным результатам в области температур $\Phi\Pi A\Phi 1 \rightarrow A\Phi 2$ наблюдались как обратный, так и прямой МКЭ, возникающие при криогенных температурах в магнитных полях до 2 Тл. Максимальное значение обратного МКЭ составило $\Delta T_{ad} = -0.27$ К при начальной температуре $T_0 = 55$ К в магнитном поле 2 Тл. С ростом величины магнитного поля наблюдается смещение максимального обратного значения ΔT_{ad} в область низкотемпературной фазы. Величина обратного МКЭ в образце соединения Mn₅Si₃, измеренная в данной работе, сопоставима с уже известными значениями обратного МКЭ некоторых интерметаллических соединений на основе редкоземельных металлов: RCu₂, R₂In (R = Tb, Gd, Dy) [43-45], a также значениями МКЭ чистых редкоземельных металлов, например Tm [46].

Возникновение прямого МКЭ с максимальным значением $\Delta T_{ad} = +0.23$ К наблюдается при температуре $T_0 = 70$ К в магнитном поле 2 Тл и, вероятно, связано с влиянием нескольких конкурируюших вкладов: постепенным нарастанием коллинеарной АФМ-фазы. которое обусловлено метамагнитоструктурным $\Phi\Pi$ 1-го рода $A\Phi 1 \rightarrow A\Phi 2$ и эффектами парапроцесса. Стоит отметить, что при нагреве образца выше температуры $T_0 = 70 \text{ K}$ величина ΔT_{ad} вновь претерпевает инверсию знака и становится отрицательной. В нашем случае это может быть связано с подавлением роста высокотемпературной фазы (АФ2) низкотемпературной фазой (АФ1) за счет влияния остаточного магнитного поля, которое продолжало действовать на образец при его выключении из рабочей области сверхпроводящего магнита и составляло около 3% (~ 0.03 Tл) на расстоянии 270 мм.

Из более ранних исследований становится ясно, что неколлинеарная фаза $A\Phi 1$ в основном ответственна за возникновение обратного МКЭ, который исчезает в высокотемпературной фазе $A\Phi 2$ [30, 31, 41]. Исследования неупругого рассеяния нейтронов указывают на то, что магнитное поле вызывает флуктуации спина в системе, что оказывает существенное влияние на поведение материала и изменение его магнитной структуры [47].

Изменение магнитной энтропии материала связано с намагниченностью M, абсолютной температурой T и напряженностью магнитного поля H с помощью термодинамического соотношения Максвелла [48]:

$$\Delta S_{\text{mag}}(T, \Delta H) = \int_{0}^{H} \left(\frac{\partial M(T, H)}{\partial T}\right)_{H} dH.$$
 (1)

На рис. 5 представлена температурная зависимость изменения магнитной энтропии ΔS_{mag} , по-



Рис. 5. Изотермическое изменение магнитной энтропии ΔS_{mag} соединения Mn_5Si_3 , рассчитанное по результатам измерений полевой зависимости намагниченности M(H) в магнитных полях до 6 Тл.

лученная на основании данных полевой зависимости намагниченности M(H) в магнитных полях до 6 Тл с помощью уравнения (1), которое было аппроксимировано следующим образом:

$$\Delta S_{\text{mag}}\left(T_{\text{av}}, \Delta H\right) = \frac{\delta H}{\delta T} \sum_{i=1}^{n} M\left(T_{i+1}, H\right) - M\left(T_{i}\right), \quad (2)$$

где $\delta T = T_i - T_{i+1}$ – разница температур нижней (T_i) и верхней (T_{i+1}) изотерм намагниченности; *n* – количество точек, полученное для каждой из двух изотерм при изменении магнитного поля от начального $(H_I = 0)$ до конечного (H_F) значения при постоянном шаге $\delta H = (H_F - H_I)/(n-1)$. Значения ΔS_{mag} получены для средней температуры $T_{\text{avr}} = (T_i + T_{i+1})/2$ между двумя изотермами намагниченности.

Из температурной зависимости видно, что в области ниже точки $\Phi\Pi$ величина ΔS_{mag} имеет отрицательные значения, что обусловливает обратный МКЭ и подтверждает преобладание фазы А Φ 1. Следует отметить, что отрицательные значения ΔS_{mag} обнаружены исключительно в области неколлинеарных магнитных структур ($T \leq T_{N1}$).

Максимальное значение обратного МКЭ наблюдается в магнитном поле 6 Тл со значением $\Delta S_{mag} = -4.2 \, \text{Дж}/(\kappa \Gamma \text{K})$ при температуре $T_0 = 55 \, \text{K}$. Вероятно, приложение магнитного поля расшепляет некоторые антипараллельные спины Mn1 и Mn2, что приводит к увеличению беспорядка спиновой системы и разрушению неколлинеарного антиферромагнетизма, повышая значения магнитной энтропии, о чем упоминалось ранее [42, 47, 49]. Выше первой точки ФП происходит инверсия знака и ΔS_{mag} становится положительным, что соответствует возникновению прямого МКЭ с максимальным значением $\Delta S_{\text{mag}} = 1.5 \, \text{Дж}/(\text{кг K})$ при температуре $T_0 = 65 \text{ K}$ в магнитном поле 6 Тл.

Полученные значения обратного МКЭ для образца соединения Mn_5Si_3 достаточно хорошо согласуются с известными литературными данными. Так, в работе [32] показано максимальное значение $\Delta S_{mag} \approx -2 \ \mbox{Дж}/(\mbox{кг K})$ при изменении магнитного поля $\mu_0 H = 3 \ \mbox{Тл}$ по сравнению с $\Delta S_{mag} = -2.1 \ \mbox{Дж}/(\mbox{кг K})$ в 2 Тл в представленной работе. При изменении $\mu_0 H = 5 \ \mbox{Тл}$ авторами получено максимальное значение $\Delta S_{mag} \approx -3 \ \mbox{Дж}/(\mbox{кг K})$ в работе [31] и $\Delta S_{mag} \approx -4 \ \mbox{Дж}/(\mbox{кг K})$ в [49], тогда как в нашем случае $\Delta S_{mag} = -3.2 \ \mbox{Дж}/(\mbox{кг K})$.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведено исследование магнитных свойств соединения Mn₅Si₃, по результатам которого обнаружено наличие двух последовательных ФП 1-го рода: метамагнитоструктурный переход $A\Phi 1 \rightarrow A\Phi 2$ при температуре $T_{N1} = 66.9 \text{ K}$ и магнитоструктурный переход А $\Phi 2 \rightarrow \Pi M$ при температуре $T_{N2} = 101.4$ К. Измерение МКЭ в образце соединения Mn₅Si₃ выполнено на основе сверхпроволящей криомагнитной системы замкнутого цикла прямым методом в адиабатических условиях. Обнаружен обратный MKЭ с максимальным значением $\Delta T_{ad} = -0.27$ K при начальной температуре $T_0 = 55 \text{ K}$ в магнитном поле 2 Тл, которому соответствует изменение энтропии магнитной системы $\Delta S_{\text{mag}} = -0.4 \text{ Дж/(кг K)}.$ Выше температуры $\Phi\Pi$ 1-го рода $A\Phi1 \rightarrow A\Phi2$ происходит инверсия знака и ΔS_{mag} становится положительным, что связано с возникновением прямого МКЭ и может быть обусловлено разрушением неколлинеарного упорядочения низкотемпературной фазы и влиянием парапроцесса. Прямой МКЭ достигает максимального значения $\Delta T_{ad} = +0.23$ К при начальной температуре $T_0 = 70$ К в магнитном поле 2 Тл. Данному значению соответствует изменение магнитной энтропии $\Delta S_{\text{mag}} =$ $= -0.1 \, \text{Дж}/(\text{кг K}).$

ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 20-79-10197).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Tishin A.M., Spichkin Y.I. The Magnetocaloric Effect and its Applications. Bristol: Inst. of Phys. Publ., 2003. https://doi.org/10.1201/9781420033373
- Numazawaa T., Kamiya K., Utaki T., Matsumoto K. // Supercond. and Cryogenics. 2013. V. 15. P. 1. https://doi.org/10.9714/psac.2013.15.2.001
- Каманцев А.П., Амиров А.А., Кошкидько Ю.С. и др. // ФТТ. 2020. Т. 62. № 1. С. 117. https://doi.org/10.1134/S1063783420010151

- 4. *Konoplyuk S.M., Mashirov A.V., Kamantsev A.P. et al.* // IEEE Trans. 2018. V. MAG-54. № 1. Article No. 2500204. https://doi.org/10.1109/TMAG.2017.2761322
- von Ranke P.J., de Oliveira N.A., Alho B.P. et al. // J. Phys.: Cond. Matt. 2009. V. 21. № 5. P. 056004. https://doi.org/10.1088/0953-8984/21/5/056004
- Krenke T., Duman E., Acet M. et al. // Nature Mater. 2005. V. 4. P. 450. https://doi.org/10.1038/nmat1395
- Han Z.D., Wang D.H., Zhang C.L. et al. // Appl. Phys. Lett. 2007. V. 90. № 4. P. 042507. https://doi.org/10.1063/1.2435593
- Krenke T., Duman E., Acet M. et al. // Phys. Rev. B. 2007. V. 75. № 10. P. 104414. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.75.104414
- Batdalov A.B., Khanov L.N., Mashirov A.V. et al. // J. Appl. Phys. 2021. V. 129. № 12. P. 123901. https://doi.org/10.1063/5.0035280
- Chatterjee S., Giri S., Majumdar S., De S. K. // J. Phys. D: Appl. Phys. 2009. V. 42. № 6. Article No. 065001. https://doi.org/10.1088/0022-3727/42/6/065001
- Файзулин Р.Р., Маширов А.М., Бучельников В.Д. и др. // РЭ. 2016. Т.61. № 10. С.994. https://doi.org/10.7868/S0033849416100107
- Entel P., Sokolovskiy V.V., Buchelnikov V.D. et al. // J. Magn. Magn. Mater. 2015. V. 385. P. 193. https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2015.03.003
- Vasiliev A.N., Heczko O., Volkova O.S. // J. Phys. D: Appl. Phys. 2010. V. 43. № 5. Article No. 055004. https://doi.org/10.1088/0022-3727/43/5/055004
- Dilmieva E.T., Koshkidko Y.S., Kamantsev A.P. et al. // IEEE Trans. 2017. V. MAG-53. № 11. Article No. 2503705. https://doi.org/10.1109/TMAG.2017.2702577
- Каманцев А.П., Коледов В.В., Маширов А.В. и др.// Изв. РАН. Сер. Физическая. 2014. Т. 78. № 9. С.1180. https://doi.org/10.7868/S0367676514090105
- Caron L., Miao X.F., P Klaasse J.C. et al. //. Appl. Phys. Lett. 2013. V. 103. № 11. P. 112404. https://doi.org/10.1063/1.4821197
- Tekgul A., Cakır O., Acet M. et al. // J. Appl. Phys. 2015.
 V. 118. № 15. P. 153903. https://doi.org/10.1063/1.4934253
- Tohei T., Wada H. // J. Appl. Phys. 2003. V. 94. № 3. P. 1800. https://doi.org/10.1063/1.1587265
- Cakır O., Acet M. // Appl. Phys. Lett. 2012. V. 100. № 20. P. 202404. https://doi.org/10.1063/1.4717181
- Dias E.T., Das A., Hoser A. et al. // J. Appl. Phys. 2018.
 V. 124. № 15. P. 153902. https://doi.org/10.1063/1.5050655
- 21. Zhang H., Gimaev R., Kovalev B. et al. // Physics B: Cond. Matt. 2019. V. 558. P. 65. https://doi.org/10.1016/j.physb.2019.01.035
- Park J., Jeong S., Park I. // Cryogenics. 2015. V. 71. P. 82. https://doi.org/10.1016/j.cryogenics.2015.06.006

РАДИОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА том 68 № 4 2023

- V. 7. P. 7619. https://doi.org/10.1088/0953-8984/7/39/004
- 33. Brown P.J., Forsyth J.B., Nunez V., Tasset F. // J. Phys.:
- https://doi.org/10.1088/0953-8984/4/49/029
- 35. Silva M.R., Brown P.J., Forsyth J.B. // J. Phys.: Cond.
- Matt. 2002. V. 14. P. 8707. https://doi.org/10.1088/0953-8984/14/37/307

- 32. Gottschilch M., Gourdon O., Persson J. et al. // J. Mater. Chem. 2012. V. 22. P. 15275.
- No. 165451.
- https://doi.org/10.1016/S0925-8388(01)01776-5

https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2019.165451

- https://doi.org/10.1039/C2JM00154C
- 31. Songlin D., Dagula W., Tegus O. et al. // J. Alloys Compounds. 2002. V. 334. № 1-2. P. 242.

- Cond. Matt. 1992. V. 4. P. 10025.
- 34. Brown P.J., Forsyth J.B. // J. Phys.: Cond. Matt. 1995.

- 30. Luccas R.F., Sánchez-Santolino G., Correa-Orellana A. et al. // J. Magn. Magn. Mater. 2019. V. 489. Article

29. Судакова Н.П., Кузнецов С.И., Михельсон А.В. и др. //

- https://doi.org/10.1088/0370-1328/91/2/310 28. Menshikov A.Z., Vokhmyanin A.P., Dorofeev Yu.A. //
- https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2016.09.169 27. Lander G.H., Brown P.J., Forsyth J.B. // Proc. Phys. Soc. 1967. V. 91. № 2. P. 332.

- Compounds. 2017. V. 693. P. 32.

Phys. Status Solidi. B. 1990. V. 158. P. 319.

Докл. АН СССР. 1976. Т. 228. № 3. С. 582.

https://doi.org/10.1002/pssb.2221580132

- 26. Ren Q.Y., Hutchison W.D., Wand J.L. et al. // J. Alloys

23. Liu J., Gottschall T., Skokov K. P. et al. // Nature Mater.

2012. V. 11. P. 620.

https://doi.org/10.1038/nmat3334

- https://doi.org/10.1007/s40843-021-1711-5
- Science China Mater. 2021. V. 64. № 11. P. 2846.
- 37. Кузнецов А.С., Маширов А.В., Алиев А.М. и др. // ФММ. 2022. Т. 123. № 4. С. 425. 24. Pecharsky V.K., Gschneidner K.A., Mudryk Ya., Paudyal D. // J. Magn. Magn. Mater. 2009. V. 321. P. 3541. https://doi.org/10.1016/i.jmmm.2008.03.013 25. Guo D., Moreno-Ramirez L.M., Romero-Muniz C. et al. //
 - https://doi.org/10.31857/S0015323022040076 38. Leciejewicz J., Penc B., Szytula A. et al. // Acta Physica Polonica A. 2008. V. 113. № 4. P. 1193.
 - https://doi.org/10.12693/APhysPolA.113.1193

36. Koshkid'ko Yu.S., Ćwik J., Ivanova T.I. et al. // J. Magn.

https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2017.03.027

Magn. Mater. 2017. V. 433. P. 234.

- 39. de Almeida D.M., Bormio-Nunes C., Nunes C.A. et al. // J. Magn. Magn. Mater. 2009. V. 321. P. 2578. https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2009.03.067
- 40. Al-Kanani H.J., Booth J.G. // J. Magn. Magn. Mater. 1995. V. 140. P. 1539. https://doi.org/10.1016/0304-8853(94)01157-5
- 41. Das S.C., Pramanick S., Chatterjee S. // J. Magn. Magn. Mater. 2021. V. 529. Article No. 167909. https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2021.167909
- 42. Das S.C., Mandal K., Dutta P. et al. // Phys. Rev. B. 2019. V. 100. № 2. P. 024409. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.100.024409
- 43. Zheng X.Q., Xu Z.Y., Zhang B. et al. // J. Magn. Magn. Mater. 2017. V. 421. P. 448. https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2016.08.048
- 44. Rajivgandhi R., Arout Chelvane J., Nigam A.K. et al. // J. Alloys. Compounds. 2020. V. 815. Article No. 152659. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2019.152659
- 45. Kamantsev A.P., Koshkid'ko Yu.S, Taskaev S.V. et al. // J. Supercond. Novel Magn. 2022. V. 35. № 8. P. 2181. https://doi.org/10.1007/s10948-022-06336-z
- 46. Андреенко А.С., Белов К.П., Никитин С.А., Тишин А.М. // Успехи физ. наук. 1989. Т. 158. № 4. С. 553.
- 47. Biniskos N., Schmalzl K., Raymond S. et al. // Phys. Rev. Lett. 2018. V. 120. № 25. P. 257205. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.120.257205
- 48. Pecharsky V.K., Gschneidner K.A. // J. Appl. Phys. 1999. V. 86. № 1. P. 565.
- https://doi.org/10.1063/1.370767 49. Tegus O., Bruck E., Zhang L. et al. // Physics B: Cond. Matt. 2022. V. 319. P. 174.
 - https://doi.org/10.1016/S0921-4526(02)01119-5